查询2SD1580供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

2SD1580

三重拡散プレーナ形 NPN シリコントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Triple Diffused Planar NPN Silicon Transistor

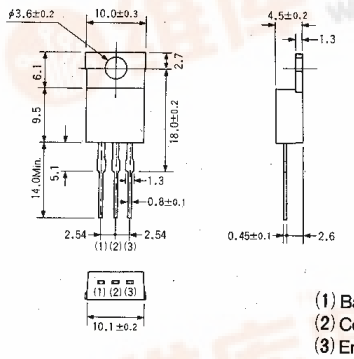
● 特長

1) $V_{CE(sat)}$=0.3V (Typ.) と低い。
(at I_C/I_B=4A/0.4A)
2) 直流電流増幅率h_{FE}の電流特性が良い。
3) P_C=40W (Tc=25℃) と大きい。
4) ASOが広い。
5) モールドタイプで実装が便利。

● Features

1) Low collector saturation voltage: $V_{CE(sat)}$=0.3V (Typ.) (I_C/I_B=4A/0.4A)
2) Excellent current response of DC current gain (h_{FE}).
3) High collector dissipation: P_c=40W (Tc=25°C)
4) Wide ASO.
5) Easy packaging because of its mold type design.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



(1) Base
(2) Collector
(3) Emitter

TO-220

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	7	A
		10	A(Pulse)
コレクタ損失	P_C	40	W(Tc=25°C)
		1.5	W(Ta=25°C)
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度範囲	T_{stg}	−55～150	°C

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	80	—	—	V	I_C =1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	100	—	—	V	I_C =50 μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E =50 μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	10	μA	V_{CB} =100V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	10	μA	V_{EB} =4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	I_C/I_B=4A/0.4A
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	I_C/I_B=4A/0.4A
直流電流増幅率	h_{FE}	60	—	320	—	V_{CE}/I_C=5V/1A
利得帯域幅積	f_T	—	5	—	MHz	V_{CE} =5V, I_E=−0.5A
出力容量	C_{ob}	—	150	—	pF	V_{CB} =10V, I_E=0A, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	D	E	F
h_{FE}	60～120	100～200	160～320

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	トレイ
		記　号	Y2
		基本発注単位(個)	200
2SD1580	DEF		○

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com